新闻动态

- 头条新闻
- 综合新闻
- 科研动态
- 学术活动

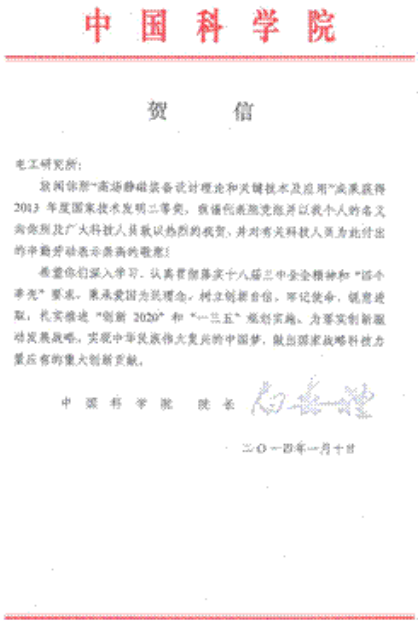
综合新闻

电工所一项成果喜获2013年度国家技术发明二等奖

作者：　日期：2014-01-22　信息来源：　【背景色 □□□□□□□□□】　【字体：大 中 小】

2014年1月10日，2013年度国家科技奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东在大会上宣读了《国务院关于2013年度国家科学技术奖励的决定》。由中国科学院电工研究所王秋良研究员等完成的“高场静磁装备设计理论和关键技术及应用”项目荣获国家技术发明二等奖。 习近平总书记、李克强总理等党和国家领导人分别向获得国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖的代表颁发了奖励证书。

中国科学院院长、党组书记白春礼向电工研究所发来贺信，代表院党组表示热烈祝贺和崇高敬意。



中　国　科　学　院

贺　　信

电工研究所：

欣闻你所“高场静磁装备设计理论和关键技术及应用”成果获得2013年度国家技术发明二等奖，我谨代表院党委并以我个人的名义向你所及广大科技人员致以热烈的祝贺，并对有关科技人员为此付出的辛勤劳动表示衷心的感谢！

希望你们深入学习、认真贯彻落实十八届三中全会精神和“两个率先”要求，秉承爱国为民理念，树立创新自信，牢记使命，锐意进取，扎实推进“创新2020”和“十三五”规划实施，为落实创新驱动发展战略，实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出国家战略科技力量应有的重大创新贡献。

中国科学院　院长　白春礼

二〇一四年一月十日

中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
中国科学院电工研究所 © 2003 ~ 2007 版权所有 京ICP备05002783号 京公网安备110402500059号
北京市海淀区中关村北二条六号 邮政信箱：北京2703信箱 邮 编：100190 E-mail：office@mail.iee.ac.cn
研究生招生电话：(010)82547015 人才招聘电话：(010)82547014 办公电话：(010)82547001 传真：(010)82547000